



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HE2955

对应国外型号
KSE2955T

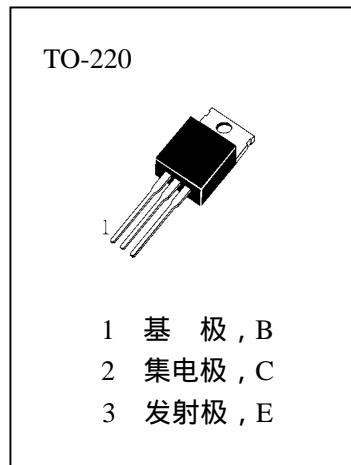
主要用途

一般放大和开关应用。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	75W
P_C ——集电极耗散功率 ($T_A=25^\circ\text{C}$)	0.6W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-70V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-60V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-10A
I_B ——基极电流.....	-6A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-60			V	$I_C=-10\text{mA}, I_B=0$
I_{CEO}	集电极—发射极截止电流			-0.7	mA	$V_{CE}=-30\text{V}, I_B=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-5	mA	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	20		100		$V_{CE}=-4\text{V}, I_C=-4\text{A}$
$H_{FE}(2)$		5				$V_{CE}=-4\text{V}, I_C=-10\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			-1.1	V	$I_C=-4\text{A}, I_B=-400\text{mA}$
				-8	V	$I_C=-10\text{A}, I_B=-3.3\text{A}$
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压			-1.8	V	$V_{CE}=-4\text{V}, I_C=-4\text{A}$
f_T	特征频率	2			MHz	$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=-0.5\text{A}$ $f=500\text{kHz}$